# Listalisi pare alto

#### Rafidain Journal of Science

https://rsci.mosuljournals.com

Vol. 31, No.4, pp. 55-68, 2022

دراسة تأثير تغيير عدة طبقات على أداء الخلية الشمسية البيروفسكايت (CH3NH3PbI3) ودراسة تأثير إضافة الطبقة العاكسة الى الخلية الشمسية باستخدام برنامج المحاكاة (SCAPS 1-D)

رداد سالم محمود وعد أحمد رسول قسم الفيزياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل

p-ISSN: 1608-9391

e -ISSN: 2664-2786

# **Article information**

Received: 8/8/2022

Accepted: 15/10/2022

DOI:

10.33899/rjs.2022.176077

corresponding author:

رداد سالم محمود

<u>raddad.20esp33@student.uo</u> mosul.edu.iq

# الملخص

يضم هذا البحث اختبار عدة مواد مختلفة لكل طبقة من طبقات الخلية الشمسية البيروفسكايت ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) ذات الخمس طبقات واختيار المادة الافضل لكل طبقة من طبقات الغلية من اجل الحصول على أعلى كفاءة للغلية الشمسية البيروفسكايت وكذلك تم دراسة تأثير كل من سمك طبقة الامتصاص وطبقة الانعكاس الخلفية على عمل الغلية الشمسية. باستخدام برنامج المحاكاة الحاسوبي ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) حيث اعتمدت مادة البيروفسكايت ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) كطبقة امتصاص في الغلية الشمسية وبسمك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) من بين عدة مواد مختلفة كطبقة الشمسية وبسمك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) من بين عده مواد مختلفة كطبقة الفاور ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) من بين عدد من الفود المختلفة كطبقة اوكسيد التوصيل الشفافة وبسمك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) وكذلك تم اختيار الطبقة الخازنة المواد المختلفة كطبقة اوكسيد التوصيل الشفافة وبسمك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) وكنلك تم اختيار الأفضل اوكسيد الزنك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) وبسمك ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) وكانت مخرجات الخلية الشمسية بالشكل التالي:  $CH_3NH_3PbI_3$ ) وكانت مخرجات الخلية الشمسية بالشكل التالي:  $CH_3NH_3PbI_3$ 

واخيرا تم اختيار طبقة الانعكاس الخلفية وهي تيلوريد الزنك (ZnTe) وبسمك ( $0.05\mu m$ ). واخيرا تم اختيار طبقة الانعكاس الخلفية وهي تيلوريد الزنك ( $CH_3NH_3PbI_3/TiO_2/ZnO/FTO$  ZnTe وكانت مخرجات الخلية الشمسية البيروفسكايت ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) النهائية بالشكل التالي: [Voc=1.288(V),  $Jsc=25..04mA/cm2,FF=89.54\%, <math>\eta=28.88\%$ 

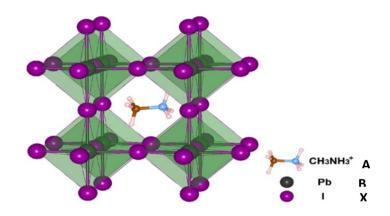
الكلمات الدالة: SCAPS 1-D خلية شمسية، بيروفسكايت.

#### المقدمة

تعد الخلية الشمسية من الاختراعات المهمة وذات فائدة كبيرة التي ظهرت في الفترة الاخيرة حيث تمكن الانسان من خلالها توفير جزء كبير من متطلباته واستخداماته اليومية للطاقة الكهربائية. والخلية الشمسية عبارة عن جهاز كهروضوئي يتركب من مادة شبه موصلة تقوم بتحويل الضوء القادم من الشمس الى تيار كهربائي مستمر يمكن استعماله والاستفادة منه (Ramprasad,2012).

تعد الخلايا الشمسية القائمة على البيروفسكايت منافس قوي لباقي الخلايا الشمسية الأخرى لما تملكه هذه الخلايا من استقرار وكفاءة عالية ويمكن اعتبارها بأنها منافس قوي للسيليكون متعدد البلورات والذي ما زال مهيمن على سوق الطاقة الكهروضوئية المتواجدة في الاسواق.

الصيغة العامة لتركيب البيروفسكايت هي  $ABX_3$  حيث ان (A,B) يمثلان ايونين موجبين بحيث يكون الايون (A) أكبر من الايون (B) ام الايون (X) هو ايون سالب ويربط بين الاكاسيد والهاليدات والشكل (1-1) يبين التركيب البلوري للبيروفسكايت (B) . (Eames  $ABX_3$ ).



الشكل 1-1: التركيب البلوري للبيروفسكايت

يتميز البيروفسكايت بثابت عزل كبير وكذلك له عمر طويل وكفاءة عالية لامتصاص الشعاع الضوئي القادم من الشمس تكون طبقة الامتصاص في الخلية من البيروفسكايت (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) وتكون من المواد الهجين العضوي واللاعضوي من هاليد القصدير او الرصاص ومن خصائص البيروفسكايت ان لها فجوة طاقة يمكن التحكم بها بواسطة الهاليد وقد تبين خلال الابحاث الحديثة ان شحنات مركبات البيروفسكايت تتواجد بشكل الكترونات حرة وفجوات لان طاقة ارتباطها منخفضة بما يكفي لفصل الشحنات عند درجة حرارة الغرفة (D'Innocenzo et al., 2014).

في الخلايا الشمسية البيروفسكايت تقع طبقة البيروفسكايت الماصة بين طبقتين احداهما تعمل على توصيل الالكترونات (ETM) ويتم توصيلها بطبقة شفافة لكي تسمح بمرور الضوء من خلالها. تعد خلية البيروفسكايت صديقة للبيئة وتمتاز ايضا في كفأتها العالية قياسا الى باقي الخلايا الشمسية الأخرى (Xiao et al., 2014).

في هذا البحث تم اختبار عده مواد مختلفة لكل طبقة من طبقات الخلية الشمسية وتم دراسة تأثير كل طبقة على كفاءة عمل الخلية عن طريق المحاكاة ألعددية باستخدام برنامج المحاكاة الحاسوبي (SCAPS 1-D).

كذلك تم دراسة تأثير طبقة الانعكاس الخلفية ودورها في زيادة كفاءة الخلية الشمسية من خلال تعزيز الناقلات من خلال عكسها نحو الوصلة الرئيسية ودورها في تقليل سمك الطبقة الماصة البيروفسكايت وبالتالي تقلل من كلفة انتاج الخلية الشمسية فكلما قل سمك طبقة الامتصاص البيروفسكايت قلت الكلفة الانتاجية للخلية الشمسية مع المحافظة على كفاءتها العالية.

# المواد وطرائق العمل

تم الاعتماد في هذا البحث على برنامج (SCAPS 1-D) في محاكاة الخلية الشمسية البيروفسكايت وهو برنامج محاكاة حاسوبي يستخدم لمحاكاة الخلية الشمسية احادي البعد صمم في قسم الالكترونيات ونظم المعلومات جامعه (Gent) في بلجيكا. يمكن من خلال البرنامج الحصول على الخصائص الكهربائية للخلية الشمسية والتي تتكون من سبع طبقات كأقصى حد للخلية ومعرفة معلمات الخلية ومنها السمك والتطعيم والعيوب ومعرفة تأثيرها على عمل الخلية والحصول على خصائص التيار -فولتية (I-V) كذلك خصائص (C-F) والكفاءة الكمية (QE) وخصائص (C-V) كذلك يمكن للباحث اختيار نوع الطيف الشمسي (عدة أطياف أو طيف أحادي) وخزن وكذلك تحميل كل إعدادات الخلية ويمكن من خلال البرنامج (SCAPS 1-D) رسم المنحنيات (Koen et al.,2011) (QE) و (I-V).

كذلك يمكن لبرنامج (SCAPS 1-D) حل المعادلات كمعادلة بوايسون والاستمرارية في أشباه الموصلات ومعادلات نقل الحاملات كذلك معادلتى كثافة التيار الانجراف والانتشار ويمكن تبيان هذه المعادلات على النحو التالى:

# اولا- معادلة بوايسون:

التي تربط العلاقة بين جهد الالكترونات  $(\Phi)$  وكثافه الشحنات والتي تعتبر البداية للحل النوعي في الكهربائية الساكنة (Chetan,2013). للمتغيرات في شبه الموصل باستخدام معادلات ماكسويل  $(D=p\Delta)$  و  $(D=p\Delta)$  في الكهربائية الساكنة (Chetan,2013).

ومن ملاحظة المعادلة رقم (1) عندما ٤ تكون ثابتة فان معادلة بوايسون تصبح بالشكل

#### ثانيا - تيار الدائرة القصيرة

التيار الذي يمر خلال الخلية عندما تكون فولتية الدائرة المفتوحة تساوي صفر. وهو اقصى تيار تعطيه الخلية الشمسية . Chetan,2013.

ويعطى بالعلاقة التالية

حيث

I− يمثل تيار دائرة الحمل

- I يمثل تيار التشبع العكسي − I

T- تمثل درجة الحرارة

k - يمثل ثابت بولتزمان

# ثالثا- فولتية الدائرة المفتوحة (Voc):

العلاقة التي يمكن من خلالها حساب فولتية الدائرة المفتوحة هي:

رابعا- معادلتي الانجراف والانتشار:

حبث انه

تمثل المجال الكهربائي

μn - يمثل حركية الالكترونات، μp - يمثل حركية الفجوات

Jn - يمثل كثافة التيار نسبة الى الالكترونات، Jp - يمثل كثافة التيار نسبة الى للفجوات

Dn - معامل الانتشار نسبة الى الالكترونات، DP -معامل الانتشار نسبة الى الفجوات

خامسا - معادلة الاستمرارية نسبة الى الالكترونات تعطى بالعلاقة التالية

تمثل عملية تولد الالكترونات Gn(x)

تمثل إعادة التركيب-Rn(x)

وكذلك فان معادلة الاستمرارية للفجوات تعطى بالعلاقة التالية:

تمثل عملية تولد الفجوات Rp(x) -تمثل أعادة التركيب - Gp(x)

#### سادسا- عامل المليء

يرمز له بالرمز FFهو النسبة بين أقصى قدرة الى أقصى كثافة تيار وفولتية يمكن ان تتولد في الخلية (Burgleman et al.,2014). كما يمكن حساب عامل المليء بالعلاقة التالية:

حيث يمثل كل من  $I_{sc}$  تيار الدائرة القصيرة و  $V_{OC}$  -فولتية الدائرة المفتوحة و  $I_{m}$  اقصى كثافة تيار وجهد متولد

#### سابعا - كفاءة الخلية الشمسية:

هي النسبة بين أعظم قدرة متولدة في الخلية الشمسية والقدرة الساقطة عليها

بمكن حساب كفاءة الخلبة بالعلاقة التالية

أيضا يمكن كتابة معادلة الكفاءة على النحو التالي

ثامنا - تركيب الخلية الشمسية واختيار طبقاتها: بعد تثبيت البيروفسكايت (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) كطبقة امتصاص للخلية الشمسية تم اختيار كل طبقة من طبقات الخلية الشمسية بالشكل التالى:

# 1. اختيار الطبقة النافذة:

في هذا البحث تم استخدام عده مواد مختلفة كطبقة نافذة وكان منها كبريتيد الكادميوم (CdS) و كبريتيد الزنك والكادميوم (CdZnS) وتيلوريد الزنك (TiO<sub>2</sub>) وكبريتيد الكاديوم المؤكسج (CdS;O) وأوكسيد التيتانيوم (TiO<sub>2</sub>) واوكسيد الكادميوم (CdO) ذات المعلمات المبينة في (الجدول 1و 2) والتي تم الحصول عليها من البحوث المنشورة.

الجدول 1: معلمات الطبقات النافذة والطبقة الماصة

Parameters	CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub>	n-CdS	n-CdZnS	n-ZnTe	n-CdS:O	n-TiO <sub>2</sub>	n-CdO
Thickness (µm)	3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Band gap (ev)	1.55	2.42	2.58	2.2	2.8	3.26	2.28
Electron affinity (ev)	3.9	4.5	4.5	3.73	4.5	4.2	4.5
Dielectric permittivity (relative)	6.5	9	9.3	10.3	10	10	5.3
CB. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	2.2E+18	2.2E+18	1.8E+19	1.2+18	2.2E+18	2.2E+18	2.2E+18
V.B. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	1.8E+19	1.8E+19	2.4E+18	1.2E+19	1.8E+19	1.8E+19	1.8E+19
Electron thermal velocity (cm/s)	1.00E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+17
Hole thermal velocity (cm/s)	1.00E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+7	1.0E+17
Electron Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	2	350	85	330	100	100	146
Hole Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	2	50	30	80	25	25	39.5
Shallow uniform donor density, N <sub>D</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	0	1.0E+17	1.0E+17	1.0E+17	1.0E+17	1.0E+17	1.0E+17
Shallow uniform acceptor density N <sub>A</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	1.00E15	0	0	0	0	0	0
Defect type	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor
Capture Cross Section Electrons (cm <sup>2</sup> )	1.00E-17	1.0E-17	1.0E-17	1.0E-17	1.0E-17	1.0E-17	1.0E-17
Capture Cross Section Hole (cm <sup>2</sup> )	1.00E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15
Nt (1/cm <sup>2</sup> )	1.00E+12	1.0E+18	1.0E+18	1.0E+18	1.0E+18	1.0E+18	1.0E+18

Kaliappan et al., 2014; Mohammad et al., 2015; Pandey et al., 2016; Shoewu et al., 2016; Ngoupo et al., 2019

الجدول 2: معلمات السطح البيني لمحاكاة الخلايا الشمسية

Parameters	n-CdS/p- MAPbI <sub>3</sub>	n-CdZnS/p- MAPbI <sub>3</sub>	n-ZnTe/p- MAPbI <sub>3</sub>	n-CdS:O/p- MAPbI <sub>3</sub>	<b>n-Ti</b> O <sub>2</sub> / <b>p-</b> MAPbI <sub>3</sub>	n-CdO/p- MAPbI <sub>3</sub>
Defect type	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Capture Cross Section Electrons (cm <sup>2</sup> )	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1× 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1× 10 <sup>-12</sup>
Capture Cross Section Hole (cm²)	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>	1 × 10 <sup>-12</sup>
Nt (1/cm <sup>2</sup> )	1 × 10 <sup>+13</sup>	1 × 10 <sup>+13</sup>	1 × 10 <sup>+13</sup>	1 × 10 +13	1 × 10 <sup>+13</sup>	1 × 10 <sup>+13</sup>

Kaliappan et al., 2014; Mohammad et al., 2015; Pandey et al., 2016; Shoewu et al., 2016; Ngoupo et al., 2019

# 2. اختيار طبقة التوصيل الشفافة (TCO):

 $V_2$  المشبع النوصيل الشفافة (TCO) تم اختبار أوكسيد القصدير المطعم بالفلور (FTO) واوكسيد الزنك المشبع بالالمنيوم (ZnO:AI) واستانات الزنك (ZTO) واوكسيد الفانديوم الخماسي ( $V_2$ O2) واوكسيد الزنك (ZTO) وحسب المعلمات المذكورة في (الجدول3). تم تثبيت الخلية (P-CH $_3$ NH $_3$ PbI $_3$ / n-TiO $_2$ ) على التوالي، تم تغير طبقات أوكسيد التوصيل الشفافة (TCO) التي تم اختبارها في هذا البحث وعند سُمك ( $0.1 \mu$ m).

الجدول 3: المعلمات الأساسية لطبقات أكاسيد التوصيل الشفافة (TCO)

Parameters	n-ZnO	n-ZnO:Al	n-ZTO	n-FTO	$\mathbf{n}$ - $\mathbf{V}_2\mathbf{O}_5$
Thickness (µm)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Band ga p (eV)	3.3	3.3	3.35	4.2	2.3
Electron affinity (eV)	4.4	4.6	4.5	4.5	3.99
Dielectric permittivity (relative)	9	7.8	9	10	4.28
CB. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	2.200E+18	2.200E+18	2.100+18	1.200+20	2.200E+18
V.B. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	1.800E+19	1.800E+19	1.500E+19	7.000E+20	1.800E+19
Electron thermal velocity (cm/s)	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7
Hole thermal velocity (cm/s)	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7	1.000E+7
Electron Mobility (cm²/Vs)	100	100	52	20	1.26
Hole Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	25	30	3	100	34.5
Shallow uniform donor density , N <sub>D</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	1.000E+19	1.000E+19	1.000E+19	1.000E+19	1.000E+19
Shallow uniform acceptor density N <sub>A</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	0	0	0	0	0
Defect type	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor
Capture Cross Section Electrons (cm <sup>2</sup> )	1.00E-15	1.00E-15	1.00E-15	1.00E-15	1.00E-15
Capture Cross Section Hole (cm <sup>2</sup> )	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12
Nt (1/cm <sup>2</sup> )	1.00E+15	1.00E+15	1.00E+15	1.00E+15	1.00E+15

Shoewu et al., 2016; Anwar et al., 2017; Shachi and Bahar, 2017

# 3. اختيار الطبقة الخازنة (BL):

(FTO) بين طبقة التوصيل (P-  $CH_3NH_3PbI_3$  /n- $TiO_2$ /n-FTO) بين طبقة التوصيل (BL) بين طبقة التوصيل (ZnO) والطبقة النافذة ( $TiO_2$ )، وقد تم اختبار الطبقات التالية كطبقة (BL) ستانيت الزنك ( $TiO_2$ ) وقد تم اختبار الطبقات التالية كطبقة (BL) ستانيت الزنك (ZnS) وكبريتيد الزنك (ZnS) وثنائي أوكسيد القصدير ( $SnO_2$ ) في هذا البحث، تم تثبيت سُمك طبقات الخازنة ( $SnO_2$ ) عند ( $SnO_2$ ) وتقليل سمك طبقة النافذة الى ( $SnO_2$ ) وحسب المعلمات المبينة في (الجدول 4).

 $P- CH_3NH_3PbI_3 / n-$  تقليل سمك الطبقة النافذة الى  $(0.05\mu m)$  وتثبيت الخلية الشمسية المكونة من ثلاث طبقات  $(0.05\mu m)$  بين (TiO $_2$  /  $(0.05\mu m)$  بين عند السِمك  $(TiO_2 / n-FTO)$  عند السِمك  $(TiO_2 / n-FTO)$  على التوالي، وإضافة الطبقات الخازنة  $(TiO_2 / n-FTO)$  طبقتي النافذة  $(TiO_2 / n-FTO)$  وأُوكسيد التوصيل الشفاف  $(TiO_3 / n-FTO)$ 

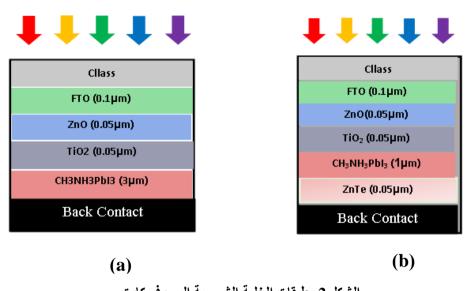
الجدول 4: المعلمات الأساسية للطبقات الخازنة (BL)

Parameters	n-Zn <sub>2</sub> SnO <sub>4</sub>	n-ZnO	n-ZTO	n-ZnS	n-SnO <sub>2</sub>
Thickness (µm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Band gap (ev)	3.35	3.0	3.35	3.5	3.6
Electron affinity (eV)	4.5	4.35	4.5	4.5	4.5
Dielectric permittivity (relative)	9	9	9	10	9
CB. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	2.0E+18	2.20E+18	2.10E+18	1.80E+18	2.20E+18
V.B. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	1.50E+19	1.80E+19	1.50E+19	1.80E+19	1.80E+19
Electron thermal velocity (cm/s)	1.0E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7
Hole thermal velocity (cm/s)	1.0E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7
Electron Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	32	100	52	100	100
Hole Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	3	25	3	25	25
Shallow uniform donor density, $N_D (1/cm^3)$	1.00E+19	1.00E+19	1.00E+19	1.00E+19	1.00E+19
Shallow uniform acceptor density N <sub>A</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	0	0	0	0	0
Defect type	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor	Single Donor
Capture Cross Section Electrons (cm <sup>2</sup> )	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15
Capture Cross Section Hole (cm <sup>2</sup> )	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12
Nt (1/cm <sup>2</sup> )	1.0E+15	1.0E+15	1.0E+15	1.0E+15	1.0E+15

Matin et al., 2010; Hossain et al., 2011; Ngoupo et al., 2015; Mahbub et al., 2017; Rassol et al., 2021

# 4. اختيار طبقة الانعكاس الخلفية (BSF):

بعد ان تم الحصول على الخلية الشمسية المكونة من أربع طبقات (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>/ZnO/FTO) لزيادة وبسمك ((2a) الخلية الشمسية ((3, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.01) لزيادة كفاءة الخلية الشمسية، هذه الطبقة تكون من نوع P-type وتقع بين طبقة الاتصال الخلفية المعدنية وطبقة الامتصاص ( $(CH_3NH_3PbI_3)$  والطبقات التي تم اختبارها في هذا البحث كطبقة انعكاس خلفية ( $(CH_3NH_3PbI_3)$  والطبقات التي تم اختبارها في هذا البحث كطبقة انعكاس خلفية ( $(CU_2Te)$ ) والسليكون ( $(CU_2Te)$ ) وكبريتيد القصدير ( $(CU_2Te)$ ) وتيلوريد النحاس ( $(CU_2Te)$ ) والسليكون ( $(CU_2Te)$ ) والجدول ( $(CU_2Te)$ ) تم إضافة طبقات الانعكاس الخلفية ( $(CU_2Te)$ ) التي تم اختيارها في هذا البحث وبسمك ( $(CU_2Te)$ ).



الشكل 2: طبقات الخلية الشمسية البيروفسكايت

الجدول 5: المعلمات الأساسية لطبقات الإنعكاس الخلفية (BSF)

		` `				
Parameters	P-AS <sub>2</sub> Te <sub>3</sub>	P-MoSe <sub>2</sub>	p-ZnTe	P-CU <sub>2</sub> Te	P-Si	P-SnS
Thickness (µm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Band gap (eV)	0.60	1.06	2.25	1.18	1.12	1.25
Electron affinity (eV)	4.0	4.37	3.65	4.20	4.05	4.20
Dielectric permittivity (relative)	20	13.6	14	10	11.9	10
CB. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	1.00E+16	2.20E+18	7.50E+17	7.80E+17	2.80E+19	2.20E+18
V.B. effective density of states (1/cm <sup>3</sup> )	1.00E+17	1.80E+19	1.50E+19	1.60E+19	2.650E+19	1.80E+19
Electron thermal velocity (cm/s)	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7
Hole thermal velocity (cm/s)	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7	1.00E+7
Electron Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	500	100	70	500	1450	100
Hole Mobility (cm <sup>2</sup> /Vs)	2100	25	50	100	600	25
Shallow uniform donor density, N <sub>D</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	0	0	0	0	0	0
Shallow uniform acceptor density N <sub>A</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	1.0E+19	1.0E+19	1.0E+19	1.0E+19	1.0E+19	1.0E+19
Defect type	Single Acceptor	Single Acceptor	Single Acceptor	Single Acceptor	Single Acceptor	Single Acceptor
Capture Cross Section Electrons (cm <sup>2</sup> )	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12	1.0E-12
Capture Cross Section Hole (cm <sup>2</sup> )	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15	1.0E-15
Nt (1/cm <sup>2</sup> )	1.0E+14	1.0E+14	1.0E+14	1.0E+14	1.0E+14	1.0E+14

Islam et al., 2011; Matin et al., 2013; Matin and Dey,2014; Rassol et al., 2021

بعد إضافة طبقة الانعكاس الخلفي والحصول على الخلية النهائية تم اختبار سمك طبقة الامتصاص من (μm 5-0.5) وبزيادة مقدارها (0.5μm) من اجل الحصول على أفضل سمك لطبقة الامتصاص بحيث تعمل الخلية الشمسية بأقصى كفاءة. كما تم دراسة تأثير تغيير سمك طبقة الانعكاس الخلفي (BSF) على معطيات الخلية الشمسية.

# النتائج والمناقشة

بعد تثبيت البيروفسكايت (CH3NH3PbI3) كطبقة امتصاص للخلية الشمسية واختيار كل طبقة من طبقات الخلية الشمسية على حدا من اجل الحصول على أقصى كفاءة للخلية ألشمسية كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما يلي:

# اولا. نتائج اختيار الطبقة النافذة:

بعد ان تم تركيب الخلية الشمسية بتثبيت الطبقة الماصة البيروفسكايت و بسمك  $(3\mu m)$  بينما سمك الطبقة النافذة  $(0.5 \ \mu m)$  و اختبار عده مواد للطبقة النافذة وكانت النتائج التي تم الحصول عليها كما في (الجدول6).

	ص البيروفسكايت	التاقدة مع طبقة الامتصا	یه اسمسیه تنطبقات	جدوں 0: محرجات الحد
Layers	Voc (v)	Jsc (mA/cm <sup>2</sup> )	FF %	(η) %
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /Cds	0.64	18.69	80.72	9.79
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /CdZnS	0.596	2.267	79.88	9.66
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /CdS:O	0.65	22.18	80.91	11.71
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /ZnTe	1.18	10.15	85.34	16.37
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> / <b>Ti</b> O <sub>2</sub>	1.26	23.68	89.06	26.58
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /CdO	0.65	16.97	81.64	9.05

الجدول 6: مخرجات الخلية الشمسية للطبقات النافذة مع طبقة الامتصاص البيروفسكايت

من ملاحظة النتائج في (الجدول 6) تبين أن أقصى كفاءة تم الحصول عليها عند استخدام (TiO<sub>2</sub>) كطبقة نافذة من بين المواد المختارة في هذا البحث ذلك بسبب فجوة الطاقة الكبيرة لها بحيث تسمح لقدر اكبر من الفوتونات من النفاذ خلالها الى طبقة الامتصاص (Laurie et al.,2016) وكان تأثير باقي المواد متقارب وبكفاءة اقل من (TiO<sub>2</sub>) بشكل واضح والخلية ذات الكفاءة الأفضل أصبحت بالشكل (P-CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/ n-TiO<sub>2</sub>).

# ثانياً. نتائج اختيار طبقة التوصيل الشفافة (TCO):

بعد ان تم اختبار عده مواد لطبقة التوصيل الشفافة كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما في (الجدول7).

الجدول 7: نتائج إختلاف طبقات أوكسيد التوصيل الشفافة حيث انه تم تثبيت السمك عند (0.1μm)

Layers	Voc (V)	Jsc (mA/cm <sup>2</sup> )	FF%	<b>Eta(η)</b> %
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO	1.26	23.60	89.02	26.48
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO:Al	1.26	23.59	81.51	24.29
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZTO	1.26	23.61	87.68	26.10
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.25	21.22	89.07	23.76
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> / <b>Ti</b> O <sub>2</sub> / <b>FTO</b>	1.26	23.66	89.06	26.56

من خلال النتائج الواردة في (الجدول 7) يمكن ملاحظة أن أفضل كفاءة تم الحصول عليها عند استخدام طبقة (FTO) كطبقة أوكسيد التوصيل الشفافة (TCO) للخلية لما تملكه من شفافية عالية تسمح للفوتونات الساقطة المرور من خلالها الى طبقة الامتصاص (Naoyuki et al., 2018) وكذلك كونها تملك فجوة طاقة أكبر من فجوة الطاقة لطبقات الخلية الشمسية الأخرى. وأصبحت الخلية (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/n-TiO<sub>2</sub>/n-FTO) هي ألخلية الأعلى كفاءة وكانت مخرجات الخلية كالتالي:

 $(V_{oc}=1.264 (V), J_{sc}=23.66 \text{ mA/cm}^2, FF=89.06 \%, \eta=26.56 \%)$ 

# ثالثاً. نتائج اختيار الطبقة الخازنة (BL):

بعد ان تم اختبار عده مواد للطبقة الخازنة كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما في (الجدول8).

الجدول 8: نتائج الخلايا باختلاف الطبقات الخازنة، حيث تم تثبيت سمك طبقة (BL) عند (0.05μm)

Layers	Voc (v)	Jsc (mA/cm <sup>2</sup> )	FF %	(η) %
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /Zn <sub>2</sub> SnO <sub>4</sub> /FTO	1.26	24.01	87.58	26.52
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.01	89.01	26.94
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> //ZTO/FTO	1.26	24.01	87.58	26.52
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> //ZnS/FTO	1.26	24.04	87.49	26.52
CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /SnO <sub>2</sub> /FTO	1.263	24.05	87.58	26.46

يلاحظ من خلال النتائج المبينة في (الجدول 8) أن طبقة (ZnO) هي أفضل طبقة خازنة (BL) والخلية الشمسية يلاحظ من خلال النتائج المبينة في (الجدول 8) أن طبقة (ZnO) هي الأعلى كفاءةً وكان لها دور كبير في تقليل عملية إعادة الاتحاد السطحي (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>/ZnO/FTO) وكانت مخرجات الخلية كالتالي:

 $(V_{oc}=1.26 (V), J_{sc}=24.01 \text{ mA/cm}^2, FF=89.01 \%, \eta=26.94 \%)$ 

# رابعا. نتائج اختيار طبقة الانعكاس الخلفية (BSF):

بعد ان تم اختبار عده مواد لطبقة الانعكاس الخلفية كانت النتائج التي تم الحصول عليها كما في (الجدول 9).

الجدول 9: نتائج الخلايا بإختلاف طبقات (BSF) حيث تم تثبيت سمك طبقات (BSF) عند (0.5µm)

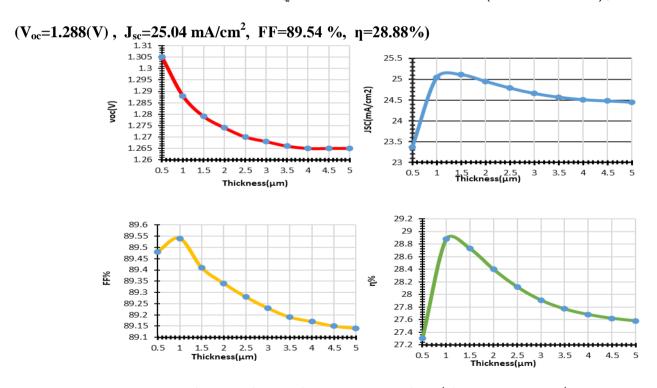
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	` ,	-	•
Layers	Voc (V)	Jsc (mA/cm <sup>2</sup> )	FF%	(η) %
CU <sub>2</sub> Te/ CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.01	89.01	26.94
Si/ CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.00	89.0	26.93
ZnTe/ CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.66	89.23	27.92
MOSe <sub>2</sub> / CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.01	89.01	26.94
AS <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> / CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.17	23.99	86.96	24.45
SnS/ CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /TiO <sub>2</sub> /ZnO/FTO	1.26	24.01	89.0	26.95

من النتائج المبينة في (الجدول9) يلاحظ بأن طبقة (ZnTe) هي أفضل طبقة انعكاس خلفية (BSF) لما تملكه من فجوة طبقة طبقة طبقة (Amin et al., 2007) والتي تعمل على تقليل إعادة الإتحاد في جهة الاتصال الخلفية كما ساهم إضافة طبقة (BSF) الى الخلية الشمسية على تقليل سُمك طبقة الامتصاص مع زيادة كفاءة الخلية الشمسية (ZnTe / CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> / TiO<sub>2</sub> / ZnO / FTO) هي الخلية الأعلى كفاءة وأصبح شكل الخلية كما في الشكل (2b) وكانت مخرجات الخلية كالتالى:

 $(V_{oc}=1.26 (V), J_{sc}=24.66 \text{ mA/cm}^2, FF=89.23 \%, \eta=27.92 \%)$ 

# خامسا. تأثير طبقة الانعكاس الخلفية على سمك طبقة الامتصاص

بعد إضافة طبقة الانعكاس الخلفي والحصول على الخلية النهائية تم اختبار سمك طبقة الامتصاص من (0.5-5 μm) وبزيادة مقدارها (0.5μm) من اجل الحصول على افضل سمك لطبقة الامتصاص بحيث تعمل الخلية الشمسية بأقصى كفاءة وكانت افضل كفاءة للخلية عندما كان سمك الطبقة الماصة بمقدار (1μm) كما في الشكل (3) مما ساهم في تقليل سمك طبقة الامتصاص في الخلية الشمسية وبالتالي تقليل كلفتها الانتاجية ويعود ذلك لكون طبقة الانعكاس الخلفية (BSF) تعمل على تقليل إعادة الإتحاد في جهة الاتصال الخلفية كما تعزز الناقلات من خلال عكسها نحو الوصلة الرئيسية وهذا يساهم في زيادة الكفاءة بشكل كبير (Amin et al.,2007) وكانت معطيات الخلية الشمسية كما يلي:

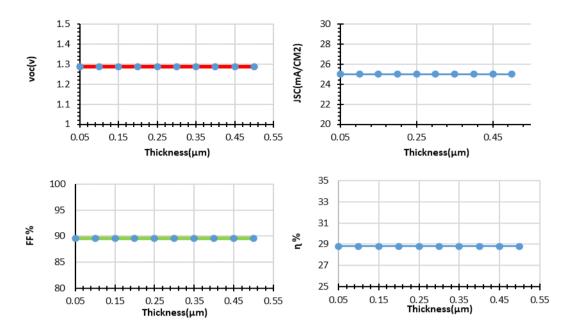


الشكل 3: تأثير تغيير سمك الطبقة ألماصة على مخرجات الخلية الشمسية بعد إضافة (BSF).

# سادسا. دراسة تأثير تغيير سمك طبقة الانعكاس الخلفي (BSF) على معطيات الخلية الشمسية:

بعد ان تم دراسة تغيير سمك طبقة الانعكاس الخلفي (0.05-0.5μm) وبزيادة مقدارها (0.05μm) وتثبيت سمك طبقة الامتصاص عند (1μm) تبين انه لم يؤثر تغيير سمك طبقة الانعكاس الخلفية على كفاءة الخلية وبقيت مخرجات الخلية الشمسية ثابتة وكما في الشكل (4) حيث تم الحصول على المعطيات التالية:

 $V_{oc}=1.288(V)$ ,  $J_{sc}=25.04$  mA/cm<sup>2</sup>, FF=89.54 %,  $\eta=28.88\%$ )



الشكل 4: تأثير تغيير سمك الطبقة العاكسة على مخرجات الخلية الشمسية.

#### الاستنتاجات

في هذه الدراسة وجد ان اختلاف مادة الطبقة النافذة له تأثير على كفاءة الخلية الشمسية البيروفسكايت حيث كانت  $(TiO_2)$  كما تبين ان اختلاف مادة طبقة اوكسيد التوصيل الشفافة له تأثير على كفاءة الخلية الشمسية البيروفسكايت حيث ان افضل مادة كانت (FTO) وأيضا أظهرت الدراسة ان اختلاف مادة الطبقة الخازنة له تأثير على كفاءة الخلية الشمسية البيروفسكايت حيث ان افضل مادة كانت (ZnO) وكان للطبقة الخازنة تأثير على سمك الطبقة النافذة وتقليل سمك الطبقة النافذة (ZnTe) الختلاف مادة طبقة الانعكاس الخلفي له تأثير على كفاءة الخلية الشمسية البيروفسكايت حيث ان أفضل مادة كانت (ZnTe) طبقة الانعكاس الخلفي لها تأثير على تقليل سمك طبقة الامتصاص البيروفسكايت  $(CH_3NH_3PbI_3)$  الى  $(\mu m)$  مما ساهم في نقليل كلفة انتاج الخلية الشمسية وكانت النتائج النهائية للخلية الشمسية التي تم الحصول عليها في هذا البحث هي:  $(V_{0c}=1.288(V), J_{sc}=25.04 \text{ mA/cm}^2, FF=89.54 %, <math>\eta=28.888\%)$ 

### المصادر

- Amin, N.; Sopian, K.; Konagai, M. (2007). Numerical modeling of CdS / CdTe and CdS / CdTe /ZnTe solar cells as a function of CdTe thickness. *Solar Energy Mater. and Solar Cells*, **91**(13), 1202 1208. doi:10.1016/j.solmat. 2007.04.006
- Anwar, F.; Afrin, S.; Satter, S.S.; Mahbub, R.; Ullah, S.M. (2017). Simulation and performance study of nanowire CdS/CdTe solar cell. *International J. Renewable Energy Research*. 7.2: 885-893. DOI:10.20508/ijrer.v7i2.5688.g7068.
- Burgleman, M.; Decock, K.; Niemegeers, A.; Verschraegen, J.; Degrave, S. (2014). SCAPS manual, no May.
- Chetan, S.S. (2013). "Solar Photovoltaic Fundamentals, Technologies and Applications". 2<sup>nd</sup> ed., PHI Learning Private Limited, Delhi-110092.
- D'Innocenzo, V.; Grancini, G.; Alcocer, M.J.; Kandada, A.R.; Stranks, S.D.; Lee, M.M.; Lanzani, G.; Snaith, H.J.; Petrozza, A. (2014). Excitons versus free charges in organo-lead tri-halide perovskites. *Nature Communicat.*, **5**, 3586. doi.org/10.1038/ncomms4586
- Eames, C.; Frost, J.M.; Barnes, P.R.; O'Regan, B.C.; Walsh, A.; Islam, M.S. (2015). Ionic transport in hybrid lead iodide perovskite solar cells. *Nature Communicat.*, **6**, 7497.

- doi.org/10.1038/ncomms8497
- Green, M.; Ho-Baillie, A.; Snaith, H. (2014). The emergence of perovskite solar cells. *Nature Photon.*, **8**(7), 506–514. Doi: 10.1038/NPHOTON.2014.134.
- Hossain, S.; Amin, N.; Aliyu, M.M.; Razykov, T.M.; Kamaruzzaman; Arabia, S. (2011). A numerical study on the prospects of high efficiency ultra-thin znxcd1-xS/CdTe solar cell. *Chalcogen. Letters*, **8**, 263-272. Corpus ID: 111382649
- Islam, M.A.; Sulaiman, Y.; Amin, N. (2011). A Comparative study of BSF layers for ultra-thin CdS: O/CdTe solar cells. *Chalcogen. Letters*, **8**(2), 65 75.
- Kaliappan, Sh.; Palanivel, S.; Raman, S.; Ramraj, R.; Ramamurthi, K. (2014). Structural, optical and electrical properties of transparent conducting hydrophobic cadmium oxide thin films prepared by spray pyrolysis technique. *Superlatt. and Microstruct.*, **69**. 29-37, ISSN 0749-6036, Doi: 10.1016/j.spmi.2014.01.018.
- Koen, D.; Samira, Kh.; Marc, B. (2011). Modelling multivalent defects in thin film solar cells. *Thin Solid Films*, **519**(21), 7481-7484.doi.org/10.1016/j.tsf.2010.12.039
- Laurie, J.; Phillips, A.; Rashed, M.; Robert, E.; Treharne, J.K.; Peter, Y.; Ivona, Z.; Mitrovic, A.W.; Steve Hall; Ken Durose (2016). Maximizing the optical performance of planar CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> hybrid perovskite heterojunction stacks. *Solar Energy Mater. and Solar Cells*, **147**, 327-333. ISSN 0927-0248, doi.org/10.1016/j.solmat.2015.10.007.
- Mahbub, R.; Islam, M.S.; Anwar, F.; Satter, S.S.; Ullah, S.M. (2017). Simulation of CZTS thin film solar cell for different buffer layers for high efficiency performance. *Engineering and Technol.*, **2**(52), 1-10.
- Mahbub, R.; Islam, Md.S.; Anwar, F.; Satter, S.; Ullah, S.M. (2017). Simulation of CZTS thin film solar cell for different buffer layers for high efficiency performance. *South Asian J. Engineering and Technol.*, **2**, 1-10.
- Matin, M.A.; Tomal, M.U.; Robin, A.M. (2013). Copper telluride as a Nobel BSF material for high performance ultra-thin CdTe PV cell. In 2013 *International Conference on Informatics, Electronics and Vision.*, 1-5. Doi:10.1109/ICIEV.2013.6572527.
- Matin, M.A.; Dey, M. (2014). High performance ultra-thin CdTe solar cell with Lead Telluride BSF. International Conference on Informatics. *Electronics and Vision* (ICIEV), 1-5. DOI:10.1109/ICIEV.2014.6850826
- Matin, M.A.; Mannir, A.M.; Abrar, H.Q.; Nowshad, A. (2010). Prospects of novel front and back contacts for high efficiency cadmium telluride thin film solar cells from numerical analysis. *Solar Energy Materials and Solar Cells.*, **94**(9), 1496-1500, doi.org/10.1016/j.solmat.2010.02.042.
- Mohammad, I.H.; Fahhad, H.A.; Nouar, T. (2015). Copper oxide as inorganic hole transport material for lead halide perovskite based solar cells. *Solar Energy*, **120**, 370-380,ISSN 0038-092X, <a href="https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.07.040">https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.07.040</a>.
- Naoyuki Shibayama, Shota Fukumoto, Hidetaka Sugita, Hiroyuki Kanda, Seigo Ito (2018). Influence of transparent conductive oxide layer on the inverted perovskite solar cell using PEDOT: PSS for hole transport layer. *Mater. Research Bullet.* **106**, 433-438, ISSN 0025-5408, doi.org/10.1016/j.materresbull.2018.06.037.
- Ngoupo, A.; Ouedraogo, S.; François, Z.; Ndjaka, J. (2015). New architecture towards ultrathin CdTe solar cells for high conversion efficiency. *International J. Photoen.*, 1-9. doi.org/10.1155/2015/961812
- Ngoupo, A.; Teyou, S.; Ouédraogo; Ndjaka, J.M. (2019). Numerical analysis of interface properties effects in CdTe/CdS: O thin film solar cell by SCAPS-1D. *Indian J. Phys.*, **93**(7), 869-881. 10.1007/s12648-018-01360-z.
- Pandey, S.K.; Krishna, K. (2016). "Device Modeling, Optimization and Analysis of CdTe Solar

- Cell." 2016 IEEE Uttar Pradesh Section International Conference on Electrical, Computer and Electronics Engineering (UPCON). pp. 295-299. IEEE. DOI:10.1109/UPCON.2016.7894668
- Ramprasad Chandrasekharan. "Numerical Modeling of Tin-Based Absorber Devices for Cost-Effective Solar Photovoltaics." A Dissertation in Energy and Geo-Environmental Engineering, 2012.
- Rassol, R.A.; Hasan, R.F.; Ahmed, S.M. (2021). Numerical analysis of SnO<sub>2</sub>/Zn2SnO4/n-CdS/p-CdTe solar cell using the SCAPS-1D simulation software. *Iraqi J. Sci.*, 505-516. DOI:10.24996/IJS.2021.62.2.17
- Shachi, S.I.; Bahar, A.N. (2017). Dataset representing the effect of indirect band gap region of Cd-free AlGaAs buffer layer in Cu (In, Ga) Se photovoltaic cell. *Data in brief*, **14**, 618–622. doi.org/10.1016/j.dib.2017.08.017
- Shoewu, E.; Oluwagbemiga; Anuforonini, G.; Duduyemi, O. (2016). Simulation of the performance of CdTe/CdS/ZnO multiiunction thin film solar cell. Review Informat. Engineer. and Applicat., 3. 1-10. Doi:10.18488/journal.79/2016.3.1/79.1.1.10.
- Xiao, Z.; Bi, Ch.; Shao, Y.; Dong, Q.; Wang, Qi; Yuan, Y.; Wang, Ch.; Gao, Y.; Huang, J. (2014). Efficient, high yield perovskite photovoltaic devices grown by interdiffusion of solution-processed precursor stacking layers. *Energy Environ. Sci.*, **7**, 1-3. doi.org 10.1039/C4EE01138D.

# Studying the Effect of Changing Several Layers on the Performance of the Perovskite Solar Cell (CH3NH3PbI3) and Studying the Effect of Adding the Back Surface Filed layer to the Solar Cell Using the Simulation Program (SCAPS 1-D)

#### Raddad S. Mahmoud

#### Raad A. Rasoul

Department of Physics/ College of Education for Pure Sciences/ University of Mosul

#### **ABSTRACT**

This research includes testing several different materials for each layer of the five-layer perovskite solar cell (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) and choosing the best material for each layer of the cell in order to obtain the highest efficiency of the perovskite solar cell, as well as studying the effect of both the thickness of the absorption layer and the back surface field layer on the performance of the solar cell using the computer simulation program (SCAPS1-D), where the perovskite material (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) was adopted as an absorption layer in the solar cell with a thickness of (1  $\mu$ m), and titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) was selected from among several different materials as a window layer with a thickness of (0.05  $\mu$ m), Fluorine-doped tin oxide (FTO) was selected from among a number of different materials as a transparent conductive oxide layer with a thickness of (0.1  $\mu$ m), as well as a buffer layer of zinc oxide (ZnO) with a thickness of (0.05 $\mu$ m) and after studying each cell layer and selecting the best one for each layer the structure of the four-layer solar cell became as follows:

(CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>/ZnO/FTO).

The outputs of the solar cell were as follows: [Voc=1.263(V), Jsc=24.01 mA/cm2, FF=89.017%,  $\eta$ =26.94%]. Finally, the back surface field layer was selected, which is zinc telluride (ZnTe) with a thickness of (0.05 m $\mu$ ). The structure of the five-layer solar cell became as follows: (ZnTe /CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>/ZnO/FTO)). The final output of the perovskite solar cell (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) was as follows: [Voc=1.288(V), Jsc=25.04mA/cm2, FF=89.54%,  $\eta$ =28.88%].

Keywords: SCAPS 1-D, solar cell, perovskite.